製 品 仕 様 書

<u>品名:SSM1003M</u>

LF No.2502

端子部鉛フリー品

Pb Free Pins

承認	審	查	作成	
Masahiro Sasaki	Masac	Ueno	Hiroshi Takakashi	
サンケン電気株式会社	技術開発本部 I	Cシステム技術組	統括部 IC応用技術部	
発行年月日		2004 / 1 / 14		
仕様書番号		SSJ-02600		

1 適用範囲

Scope

この規格は、高圧三相モータドライバIC SSM1003Mについて適用する。 The present specifications shall apply to an SSM1003M.

2 概要

Outline

種別	半導体集積回路(ハイブリッドIC)
Type	Semiconductor IC (Hybrid IC)
構造	樹脂封止型(トランスファーモールド)
Structure	Plastic package (Transfer mold)
主用途	高圧三相モータドライブ
Applications	High voltage 3 phase motor drive

3 絶対最大定格(Ta=25)

Absolute maximum ratings (Ta=25)

項目	記号	規格	単位	条件
Characteristic	Symbol	Ratings	Units	Remarks
主電源電圧	VBB	450	V	VBB-GND 間
Main supply voltage	V DD	430	V	Between VBB and GND
制御電源電圧	VCC	20	V	VCC-COM 間
Logic supply voltage	VCC	20	•	Between VCC and COM
制御電源電圧	VBS	20	V	VB-HS(U,V,W)間
Boot-strap voltage	V DS	20	•	Between VB and HS (U,V,W)
出力電流(連続)	IO	15	Α	Tc=25
Output current (continued)	10	13	7.1	10-25
出力電流(パルス)	IOP	30	A	PW 5ms
Output current (pulsed)	101	30	7.1	1 ** 51115
入力電圧	VIN	-0.5 to +7	V	
Input voltage	VII.	0.5 to 17	•	
RCIN 端子電圧	VRC	20	V	RC-COM 間
RCIN terminal voltage	, ite	20	,	Between RC and COM
許容損失	PD	33	W	Tc=25 , IGBT 1 素子当り
Maximum allowable power dissipation	10	33	**	Tc=25 , 1 element operation
		3.79		IGBT 1 素子当り
熱抵抗(接合・ケース間)	j-c	3.17	/W	1 element operation (IGBT)
Thermal resistance (junction to case)) .	5.43	/ * *	FWD 1 素子当り
		3.43		1 element operation (FWD)
動作ケース温度	TOP	-20 to +100		
Case operation temperature	101	20 to 1100		
接合温度(パワー部)	Tj	+150		
Junction temperature (IGBT)	-1,	1130		
保存温度	Tstg	-40 to +150		
Storage temperature	1505	10 10 1150		
				裏面 FIN-樹脂部(取付穴含)-
絶縁耐圧	Viso	1500	Vrms	リード端子間 AC 1分間
Isolation voltage	1150	1500	, , , , , ,	Among FIN,resin and each pin
				1 minute, AC
シャント抵抗許容損失	777	_	***	T 05
Allowable power dissipation for shunt	PR	6	W	Tc=25
resistance				
負荷短絡耐量	SC	8	us	VBB=300V, VCC=15V
Capability for load short-circuit				<u>,</u>

040114 SSJ-02600 1 / 14

4 電気的特性

Electrical characteristics

4-1 電気的特性(Ta=25)

Electrical characteristics (Ta=25degC)

項目	記号	‡ 目	格値 Lim	vito	単位	条件
Characteristics	Symbol	MIN	TYP	MAX	Units	Conditions
制御電源電圧	·		111			VCC-COM 間
Logic supply voltage	VCC	13.5		16.5	V	Between VCC and COM
制御電源電流						
Logic supply current	ICC			3	mA	VCC=15V
入力電圧	VIH	4				VCC=15V,Output:ON
Input voltage	VIL			1		VCC=15V,Output:OFF
入力電圧ヒステリシス幅					V	1
Input voltage hysteresis	VH		0.8			VCC=15V
入力電流	IIHH		50	100		VCC=15V,VIN=5V
Input current(High Side)	IILH			2	<u> </u>	VCC=15V,VIN=0V
入力電流	IIHL		8	20	uA	VCC=15V,VIN=5V
Input current(Low Side)	IILL			2		VCC=15V,VIN=0V
ハイサイド制御電源低下保護電圧	UVHL	9.5		11.5		·
Under voltage lock out (High side)	UVHH	10.0		12.0		
ローサイド制御電源低下保護電圧	UVLL	10.0		12.0	***	NOC 15N
Under voltage lock out (Low side)	UVLH	10.5		12.5	V	VCC=15V
FO端子出力電圧	VFOL	0		1.0		
FO terminal output voltage	VFOH	4.0		5.5	1	
FO端子出力電流	IFOL			-1	mA	VCC=15V,VFOL=1V
FO terminal output current	IFOH			+1	mA	VCC=15V,VFOH=4V
過電流保護トリップ電圧	LITTOLD	0.45	0.50	0.55		NGC 15V
Over current protection trip voltage	VTRIP	0.45	0.50	0.55		VCC=15V
	_					VRC=15V,RC=1M
過電流保護保持時間	tp1		260		us	CC=1000pF,RB=30k
Over current protection hold time						VRC=5V,RC=1.5M
The state of the s	tp2		5		ms	CC=2200pF,RB=30k
ブランキングタイム						
Blanking time	tbk		1.6		us	VCC=15V,RB=30k
I G B T 出力耐圧						VCC=15V,IC=250uA
IGBT breakdown voltage	VCES	600			V	VIN=0V
IGBT出力漏れ電流						VCC=15V,VCE=600V
IGBT leakage current	ICES			1	mA	VIN=0V
IGBT出力飽和電圧	TIOE ()		2.2	2 -		VCC=15V,IC=15A
IGBT saturation voltage	VCE(sat)		2.2	2.6	* 7	VIN=5V
ダイオード順電圧	1777		2.0	2.4	V	VCC=15V,IF=15A
Diode forward voltage	VF		2.0	2.4		VIN=0V
ダイオード逆回復時間	4		50			TE 15 A 1:/1. 100 A /
Diode recovery time	trr		50		ns	IF=15A,di/dt=100A/us
· ·	td(on)		0.6			
ハイサイドスイッチング時間	tr		0.1			
High side switching time	td(off)		0.5			
	tf		0.07		us	VBB=280V,VCC=15V
	td(on)		0.3		us	IC=15A,VIN=0<=>5V
ローサイドスイッチング時間	tr		0.1			Inductive load
Low side switching time	td(off)		0.3			
	tf		0.07			4
上下ディレーマッチング	MT		0.2		us	
Difference of switching time						
シャント抵抗	RS	24.2	25	25.8	m	IR=15A
Shunt resistance	1					1

040114 SSJ-02600 2 / 14

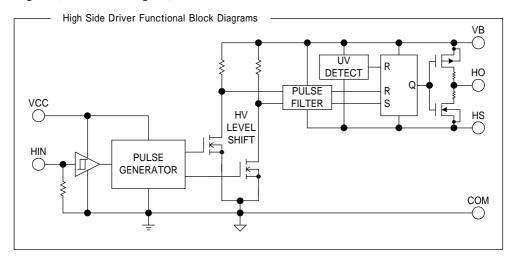
4-2 推奨動作条件

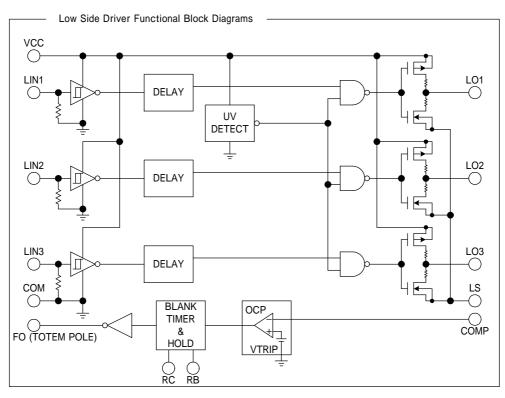
Recommended operating conditions

項目	記号	規格 Ratings			単位	条件
Characteristic	Symbol	MIN	TYP	MAX	Units	Remarks
主電源電圧 Main supply voltage	VBB		300	450	V	VBB-LS 間 Between VBB and LS
制御電源電圧 Logic supply voltage	VCC	13.5		16.5	V	VCC-COM 間 Between VCC and COM
入力信号デッドタイム Dead time	tdead	2.5			us	
キャリア周波数 Carrier frequency	Fc			18	kHz	
接合温度 Junction Temperature	Tj			125		

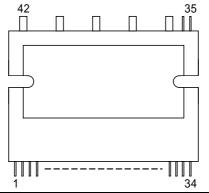
5 ブロックダイアグラム (ピン配置)

Block diagram (Connection diagram)





040114 SSJ-02600 3 / 14



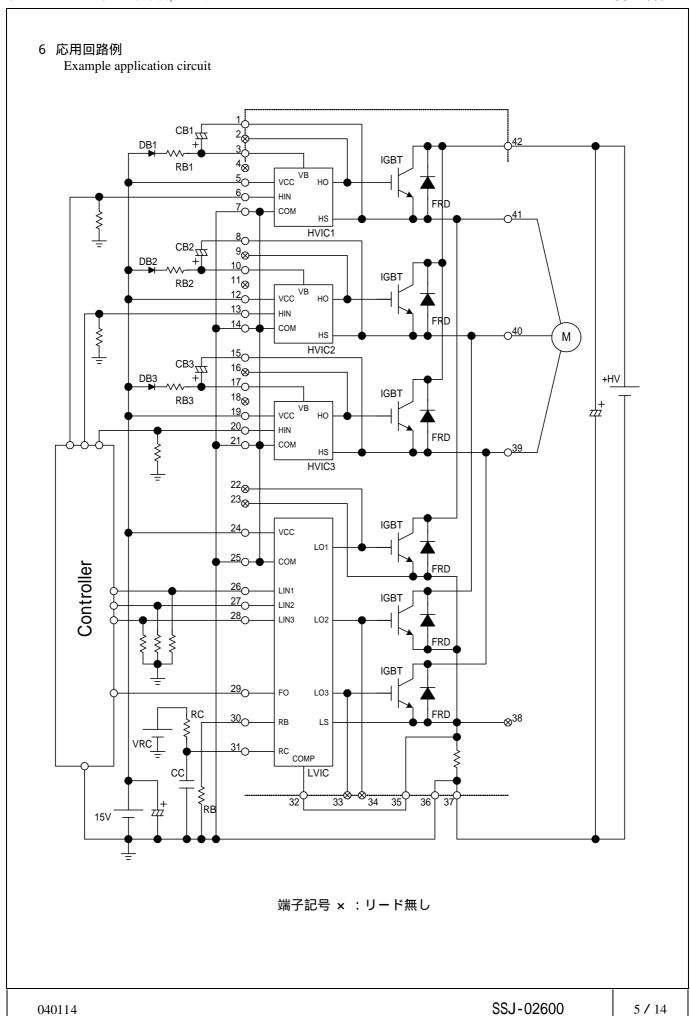
端子名称欄補足

:リード根元で切断

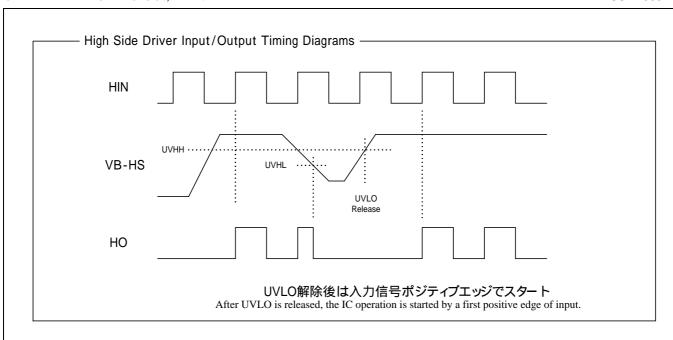
	: リード無し
2.4	

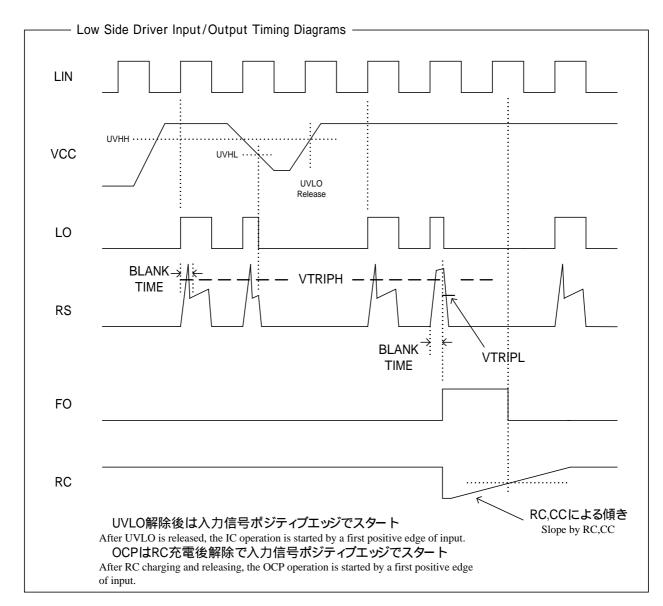
1		100 = 4-31	1 34
High Side IGBTゲート端子(U相)	PIN番号	端子名称	機能
3		H S 1	High Side フローティング基準端子(U相)
NC			
S	3	V B 1	High Side フローティング電源端子(U相)
日	4		N C
	5	V C C 1	High Side コントロール回路電源端子(U相)
B	6	HIN1	High Side 相入力端子(U相、アクティブH)
R	7	C O M 1	High Side コントロール回路GND端子(U相)
10	8	H S 2	High Side フローティング基準端子(V相)
1 1	9		High Side IGBTゲート端子(V相)
1 1	1 0	V B 2	High Side フローティング電源端子(V相)
13 HIN2 High Side 相入力端子(V相、アクティブH) 14 COM2 High Side コントロール回路GND端子(V相) 15 HS3 High Side フローティング基準端子(W相) 16 High Side IGBTゲート端子(W相) 17 VB3 High Side JGBTゲート端子(W相) 18 NC 19 VCC3 High Side コントロール回路電源端子(W相) 20 HIN3 High Side 相入力端子(W相、アクティブH) 21 COM3 High Side コントロール回路GND端子(W相) 22 Low Side IGBTゲート端子(U相) 23 Low Side IGBTボミッタ端子 24 VCC4 Low Side 国入力端子(U相) 25 COM4 Low Side 相入力端子(U相、アクティブH) 27 LIN1 Low Side 相入力端子(V相、アクティブH) 27 LIN2 Low Side 相入力端子(V相、アクティブH) 28 LIN3 Low Side 相入力端子(W相、アクティブH) 29 FO 過電流検出フェール信号出力端子(V相、アクティブH) 30 RB ブランキングタイム設定用抵抗接続端子 31 RC 過電流保護用コンパレータ入力端子(W相) 32 COMP 過電流保護用コンパレータ入力端子(W相) 33 Low Side IGBTゲート端子(V相) 34 Low Side IGBTゲート端子(W相) 35 RS + シャント抵抗センス端子(・側) <td>1 1</td> <td></td> <td></td>	1 1		
13	1 2	V C C 2	High Side コントロール回路電源端子(V相)
14 COM2 High Side コントロール回路GND端子(V相) 15 HS3 High Side JGBTゲート端子(W相) 16 High Side IGBTゲート端子(W相) 17 VB3 High Side JDーティング電源端子(W相) 18 NC 19 VCC3 High Side JDトロール回路電源端子(W相) 20 HIN3 High Side JDトロール回路電源は子(W相) 21 COM3 High Side JDトロール回路GND端子(W相) 22 Low Side IGBTゲート端子(U相) 23 Low Side IGBTエミッタ端子 24 VCC4 Low Side JDトロール回路GND端子 25 COM4 Low Side JDトロール回路GND端子 26 LIN1 Low Side Alphama (W相) 27 LIN2 Low Side Alphama (W相) 28 LIN3 Low Side Alphama (W相) 29 FO 過電流検出フェール信号出力端子(フェール時 Hレベル信号出力) 30 RB ブランキングタイム設定用抵抗接続端子 31 RC 過電流候護保持用RC接続端子 32 COMP 過電流保護用コンパレータ入力端子 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(・側) 37 GND 主電原のND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子	1 3	HIN2	
15	1 4	C O M 2	
16	1 5	H S 3	
17	1 6		
18	1 7	V B 3	
20 HIN3 High Side 相入力端子(W相、アクティブH) 21 COM3 High Side コントロール回路GND端子(W相) 22 Low Side IGBTゲート端子(U相) 23 Low Side IGBTTエミッタ端子 24 VCC4 Low Side コントロール回路電源端子 25 COM4 Low Side 相入力端子(U相、アクティブH) 27 LIN1 Low Side 相入力端子(V相、アクティブH) 28 LIN3 Low Side 相入力端子(W相、アクティブH) 29 FO 過電流検出フェール信号出力端子(フェール時 Hレベル信号出力) 30 RB ブランキングタイム設定用抵抗接続端子 31 RC 過電流保護保持用RC接続端子 32 COMP 過電流保護開コンパレータ入力端子 33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W相出力端子 40 V V相出力端子 41 U 切相出力端子	1 8		
21 COM3 High Side コントロール回路GND端子(W相) 22 Low Side IGBTゲート端子(U相) 23 Low Side IGBTTエミッタ端子 24 VCC4 Low Side コントロール回路電源端子 25 COM4 Low Side AD力端子(U相、アクティブH) 26 LIN1 Low Side AD力端子(V相、アクティブH) 27 LIN2 Low Side AD力端子(W相、アクティブH) 28 LIN3 Low Side AD力端子(W相、アクティブH) 29 FO 過電流検出フェール信号出力端子(フェール時 Hレベル信号出力) 30 RB ブランキングタイム設定用抵抗接続端子 31 RC 過電流保護保持用RC接続端子 32 COMP 過電流保護保持用RC接続端子 33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS + シャント抵抗センス端子(+側) 36 RS - シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 40 V V相出力端子 40 V V相出力端子	1 9	V C C 3	High Side コントロール回路電源端子(W相)
22 Low Side IGBTゲート端子(U相) 23 Low Side IGBTエミッタ端子 24 VCC4 Low Side コントロール回路電源端子 25 COM4 Low Side 相入力端子(U相、アクティブH) 26 LIN1 Low Side 相入力端子(V相、アクティブH) 27 LIN2 Low Side 相入力端子(V相、アクティブH) 28 LIN3 Low Side 相入力端子(W相、アクティブH) 29 FO 過電流検出フェール信号出力端子(フェール時 Hレベル信号出力) 30 RB ブランキングタイム設定用抵抗接続端子 31 RC 過電流保護保持用RC接続端子 32 COMP 過電流保護用コンパレータ入力端子 33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(W相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(・側) 36 RS- シャント抵抗センス端子(・側) 37 GND 主電源GND端子 10 V相出力端子 40 V V相出力端子 40 V V相出力端子 41 U U相出力端子	2 0	HIN3	High Side 相入力端子(W相、アクティブH)
23 Low Side IGBTエミッタ端子 24 VCC4 Low Side コントロール回路電源端子 25 COM4 Low Side コントロール回路GND端子 26 LIN1 Low Side 相入力端子(U相、アクティブH) 27 LIN2 Low Side 相入力端子(V相、アクティブH) 28 LIN3 Low Side 相入力端子(W相、アクティブH) 29 FO 過電流検出フェール信号出力端子(フェール時 Hレベル信号出力) 30 RB ブランキングタイム設定用抵抗接続端子 31 RC 過電流保護保持用RC接続端子 32 COMP 過電流保護用コンパレータ入力端子 33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(+側) 36 RS- シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W M相出力端子 40 V 利出力端子 40 V 利出力端子	2 1	C O M 3	
23 Low Side IGBTエミッタ端子 24 VCC4 Low Side コントロール回路電源端子 25 COM4 Low Side コントロール回路GND端子 26 LIN1 Low Side 相入力端子(U相、アクティブH) 27 LIN2 Low Side 相入力端子(V相、アクティブH) 28 LIN3 Low Side 相入力端子(W相、アクティブH) 29 FO 過電流検出フェール信号出力端子(フェール時 Hレベル信号出力) 30 RB ブランキングタイム設定用抵抗接続端子 31 RC 過電流保護保持用RC接続端子 32 COMP 過電流保護用コンパレータ入力端子 33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(+側) 36 RS- シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W M相出力端子 40 V 利出力端子 40 V 利出力端子	2 2		Low Side IGBTゲート端子(U相)
25 COM4 Low Side コントロール回路GND端子 26 LIN1 Low Side 相入力端子(U相、アクティブH) 27 LIN2 Low Side 相入力端子(V相、アクティブH) 28 LIN3 Low Side 相入力端子(W相、アクティブH) 29 FO 過電流検出フェール信号出力端子(フェール時 H レベル信号出力) 30 RB ブランキングタイム設定用抵抗接続端子 31 RC 過電流保護保持用RC接続端子 32 COMP 過電流保護用コンパレータ入力端子 33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(+側) 36 RS- シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W 相出力端子 40 V 相出力端子 41 U 相出力端子	2 3		
26 LIN1 Low Side 相入力端子(U相、アクティブH) 27 LIN2 Low Side 相入力端子(V相、アクティブH) 28 LIN3 Low Side 相入力端子(W相、アクティブH) 29 FO 過電流検出フェール信号出力端子(フェール時 Hレベル信号出力) 30 RB ブランキングタイム設定用抵抗接続端子 31 RC 過電流保護保持用RC接続端子 32 COMP 過電流保護用コンパレータ入力端子 33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(+側) 36 RS- シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W相出力端子 40 V V相出力端子 41 U 相出力端子	2 4	V C C 4	Low Side コントロール回路電源端子
27 LIN2 Low Side 相入力端子(V相、アクティブH) 28 LIN3 Low Side 相入力端子(W相、アクティブH) 29 FO 過電流検出フェール信号出力端子(フェール時 H レベル信号出力) 30 RB ブランキングタイム設定用抵抗接続端子 31 RC 過電流保護保持用RC接続端子 32 COMP 過電流保護用コンパレータ入力端子 33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(+側) 36 RS- シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W 相出力端子 40 V V相出力端子 41 U U相出力端子	2 5	C O M 4	Low Side コントロール回路GND端子
28 LIN3 Low Side 相入力端子(W相、アクティブH) 29 FO 過電流検出フェール信号出力端子(フェール時 H レベル信号出力) 30 RB ブランキングタイム設定用抵抗接続端子 31 RC 過電流保護保持用R C 接続端子 32 COMP 過電流保護用コンパレータ入力端子 33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(+側) 36 RS- シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W W相出力端子 40 V V相出力端子 41 U U相出力端子	2 6	LIN1	Low Side 相入力端子(U相、アクティブH)
29FO過電流検出フェール信号出力端子(フェール時 H レベル信号出力)30RBプランキングタイム設定用抵抗接続端子31RC過電流保護保持用RC接続端子32COMP過電流保護用コンパレータ入力端子33Low Side IGBTゲート端子(W相)34Low Side IGBTゲート端子(V相)35RS+シャント抵抗センス端子(+側)36RS-シャント抵抗センス端子(-側)37GND主電源GND端子38Low Side IGBTエミッタ端子39WW相出力端子40VV相出力端子41UU相出力端子	2 7	LIN2	Low Side 相入力端子(V相、アクティブH)
30 RB ブランキングタイム設定用抵抗接続端子 31 RC 過電流保護保持用RC接続端子 32 COMP 過電流保護用コンパレータ入力端子 33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(+側) 36 RS- シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W W相出力端子 40 V 材出力端子 41 U 切相出力端子	2 8	LIN3	Low Side 相入力端子(W相、アクティブH)
31 RC 過電流保護保持用RC接続端子 32 COMP 過電流保護用コンパレータ入力端子 33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(+側) 36 RS- シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W W相出力端子 40 V V相出力端子 41 U U相出力端子	2 9	FΟ	過電流検出フェール信号出力端子(フェール時 H レベル信号出力)
32 COMP 過電流保護用コンパレータ入力端子 33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(+側) 36 RS- シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W相出力端子 40 V相出力端子 41 U相出力端子		R B	ブランキングタイム設定用抵抗接続端子
33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(+側) 36 RS- シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W W相出力端子 40 V 材出力端子 41 U 切相出力端子		R C	過電流保護保持用RC接続端子
33 Low Side IGBTゲート端子(W相) 34 Low Side IGBTゲート端子(V相) 35 RS+ シャント抵抗センス端子(+側) 36 RS- シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W W相出力端子 40 V V相出力端子 41 U U相出力端子		COMP	過電流保護用コンパレータ入力端子
35 RS+ シャント抵抗センス端子(+側) 36 RS- シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W相出力端子 40 V相出力端子 41 U相出力端子	3 3		
36 RS- シャント抵抗センス端子(-側) 37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W相出力端子 40 V相出力端子 41 U相出力端子	3 4		Low Side IGBTゲート端子(V相)
37 GND 主電源GND端子 38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W 相出力端子 40 V 日出力端子 41 U 相出力端子	3 5	R S +	シャント抵抗センス端子(+側)
38 Low Side IGBTエミッタ端子 39 W相出力端子 40 V相出力端子 41 U相出力端子	3 6	RS-	シャント抵抗センス端子(-側)
39 W W相出力端子 40 V V相出力端子 41 U U相出力端子	3 7	GND	主電源GND端子
40 V V相出力端子 41 U U相出力端子	3 8		Low Side IGBTエミッタ端子
4 1 U U相出力端子	3 9	W	W相出力端子
4 1 U U相出力端子	4 0	V	V相出力端子
4.2 VPP 土電道地ブ	4 1	U	U相出力端子
4 Z V B B 土竜凉斒丁	4 2	VBB	主電源端子

040114 SSJ-02600 4 / 14



040114





SSJ-02600

6/14

外付部品定数設定方法(計算式)

ブートストラップコンデンサ CBOOT (CB1、CB2、CB3)

CBOOT[F] > 0.0002×Ton または CBOOT > 2Qg / (Vcc-Vsat-11)

のどちらか大きい値

Ton:ハイサイド IGBT 最大 ON 時間[sec]

Qg: 45nC Vsat: 2.2V

上記の計算式には配線引き回し等で発生する電圧降下分が充分考慮されていません。また、ブートストラップ電圧が落ち込むと制御電源電圧低下保護回路が働いてしまいますので、弊社としましては計算結果の約2~3倍以上の容量値を推奨しております。

ブートストラップコンデンサ充電電流制限抵抗 RBOOT (RB1、RB2、RB3)

RBOOT[] = T / CBOOT

T:ローサイド最小 ON 時間またはハイサイド最小 OFF 時間のどちらか短い方

ブートストラップダイオード DBOOT (DB1、DB2、DB3)

ブートストラップダイオードは、耐圧 600V 以上のものを使用してください。また、ダイオードに印加されるバイアスは順、逆を繰り返しますので、高速リカバリのものを使用してください(trr = 100ns 以下)。

上記の計算式で求めた値の妥当性確認は実機動作で検証する必要があります。VB1、VB2、VB3 端子内部には制御電源電圧低下保護回路が内蔵されています。VB1、VB2、VB3 端子電圧が保護回路にかからない範囲に設定する必要があります。

過電流保護保持時間の設定方法

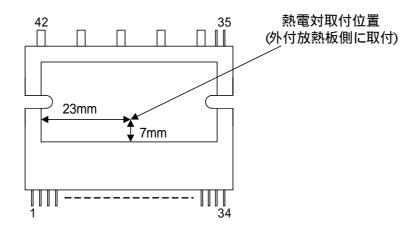
 $tp = RC \times CC \times \{-ln(1-3.5/V_{RC})\}$

ブランキングタイム設定

 $tbk[us] = 0.037 \times RB[k] + 0.61$

ケース温度測定ポイント

High Side W 相 IGBT 位置



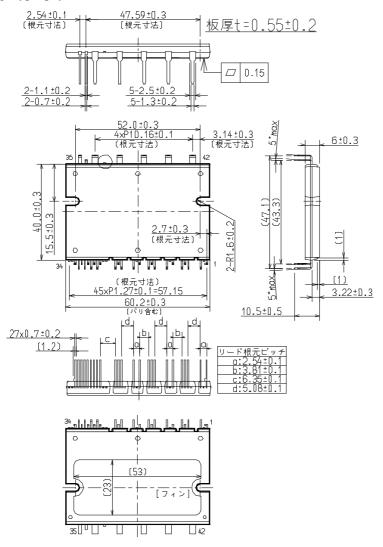
040114 SSJ-02600 7 / 14

7 外形

Package information

7-1 外形、寸法

Package type, physical dimensions



単位:mm

Dimensions in mm

A. 品名表示 SSM1003M Type Number 図番 DWGNo.:

B. ロット番号 Lot Number

040114

が Number 第1文字 1st letter

西暦年号下一桁 The last digit of year

第 2 文字 月 2nd letter Month

1 ~ 9:アラビア数字 1 to 9:Arabic Numerals

10:0,11:N,12:D

O for Oct., N for Nov., D for Dec.

第 3 , 4 文字 製造日 3rd & 4th letter day

> 0 1 ~ 3 1 01 to 31: Arabic Numerals

名称	材質	
Description	Material	Specification
リード端子 Lead terminal	Cu	Ni メッキ・ハンダディップ処理 Ni plating, solder dip (Sn-Ag-Cu)

第5文字 弊社識別 5th letter discrimination A~Z

 $A \sim Z$ A to Z

SSJ-02600

8 / 14

7-2 外観

Appearance

本体は、汚れ、傷、亀裂等なく綺麗であること。

The body shall be clean and shall not bear any stain, rust or flaw.

7-3標示

Marking

標示は本体に、品名及びロット番号を明瞭、かつ容易に消えぬようレーザーで捺印すること。

The type number and lot number shall be clearly stamped by laser on the body so that cannot be erased easily.

8 信頼性項目

Reliability

試験項目	試験項目 N 試験条件		実施(保証)
断 続 通 電 試 験	5	T=100	5000cycle
高温バイアス試験	5	Ta=125 ,VBB=450V	1000hrs
高温高湿バイアス試験	5	Ta=85 ,RH=85%,VBB=450V	1000hrs
高温保存試験	11	Ta=150	1000hrs
耐湿性試験	11	Ta=85 ,RH=85%	1000hrs
低 温 保 存 試 験	11	Ta= - 40	1000hrs
プレッシャークッカー試験	11	Ta=120 ,RH=100%,不飽和式	96hrs
熱 衝 撃 試 験	11	0~100 、各5分	100cycle
温度サイクル試験	11	Ta= - 40 ~ 150 ,各 30 分	500cycle
自 然 落 下 試 験	11	75cm,かえで板上	3 🗖
はんだ耐熱性試験	11	260 ,10Sec、本体 1.5mm まで浸漬	1 💷
14 70 72 19 天代 1主 6以 例来	11	380 ,3Sec、手半田付け条件	1 💷
はんだ付け性試験	11	245 ,5Sec	95%以上
振 動 試 験	11	EIAJ ED-4701 条件 D , E	各 16 分 / 96hrs
端 子 強 度 試 験	11	引っ張り EIAJ ED-4701 方法 、1Kgf , 10Sec	30sec
如	11	曲げ EIAJ ED-4701 方法 、0.5Kgf	2 💷
衝 撃 試 験	11	EIAJ ED-4701 条件 D	1 💷
静電耐量試験	11	C=200pF , R=0	200Vmin

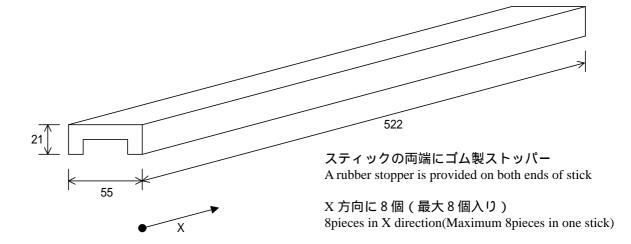
040114 SSJ-02600 9 / 14

9 梱包仕様

Packing specifications

9-1スティック

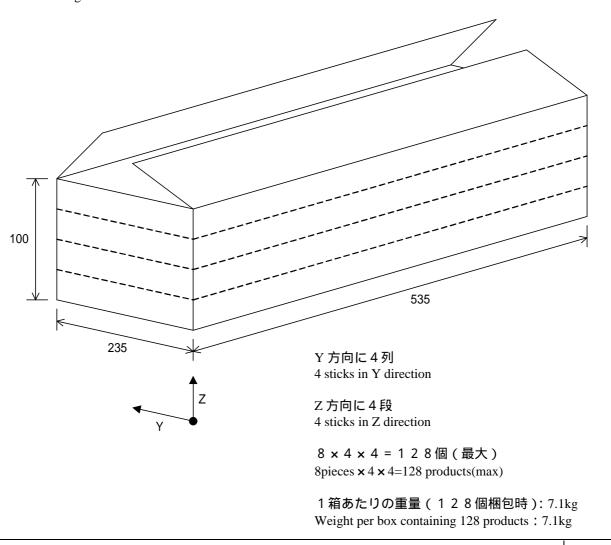
Stick



材質:PVC Material:PVC

9-2 ダンボール箱

A corrugated carton



SSJ-02600

10 / 14

9-3 梱包明細書

Packing label

製品の出荷の際に梱包明細書を貼付する。

The following information is included on a packing label.

1) 受注番号

Internal order number

2) 分納回数

Number of times on partial shipment

3) お届け先

Customer name

4) 貴社注番

Customer's P.O. number

5) 貴社品番

Customer's part number

6) 品名

Sanken part number

7) 納期

Delivery date

8) 発送日

Shipping date

9) 出荷数

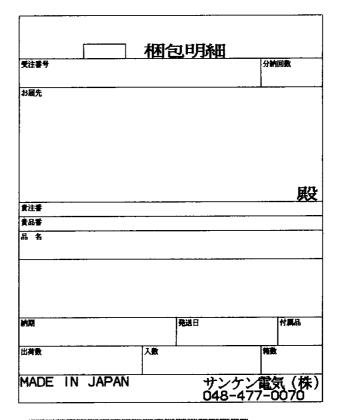
Quantity to be shipped

10) 箱数

Number of box

9-4原産国: MADE IN JAPAN

The country of origin: MADE IN JAPAN





10 使用上の注意

Cautions and warnings

⚠ 使用上の注意 CAUTION/ WARNING

保管環境、特性検査上の取り扱い方法によっては信頼度を損なう要因となりますので、注意事項 に留意されますようお願いいたします。

Since reliability can be affected adversely by improper storage environment and handling methods during Characteristic tests, please observe the following cautions.

10-1 保管上の注意事項

Cautions for Storage

保管環境は、常温 $(5 \sim 35)$ 、常湿 $(40 \sim 75\%)$ 中が望ましく、高温多湿や温湿度変化の大きな場所を避けてください。

Ensure that storage conditions comply with the standard temperature (5 to 35°) and the standard relative humidity (around 40 to 75%) and avoid storage locations that experience extreme changes in temperature or humidity.

腐食性ガス等の有毒ガスが発生しない塵埃の少ない場所で直射日光を避けてください。 Avoid locations where dust or harmful gases are present and avoid direct sunlight.

長期保管したものは、使用前に半田付け性やリードの錆等について再点検してください。 Reinspect for rust in leads and solderability that have been stored for a long time.

10-2 特性検査、取り扱い上の注意事項

Cautions for characteristic Tests and Handling

受入検査等で特性検査を行う場合は、測定器からのサージ電圧の印加、端子間ショートや誤接続等に十分ご注意ください。また定格以上の測定は避けてください。

When characteristic tests are carried out during inspection testing and other standard tests periods, protect the devices from surge of power from the testing device, shorts between the devices and the heatsink.

10-3 推奨締め付けトルク

Screwing torque

SSM1003M の締め付けトルクは78.4~88.2N・cm(8.0~9.0Kgf・cm)として下さい。

The torque of screwing the SSM1003M to the heatsink shall be 78.4 to 88.2N· cm (8.0 to 9.0Kgf· cm).

10-4放熱用シリコーングリースをご使用の際の注意

Remarks in using silicone grease for a heatsink

本製品を放熱板に取付けシリコーングリースをご使用する際は、均一に薄く塗布して下さい。必要以上に塗布することは、無理な応力を加えることになります。

When silicone grease is used in mounting this product on a heatsink, it shall be applied evenly and thinly. If more silicone grease than required is applied, it may produce forced stress.

揮発性の放熱用シリコーングリースは長時間経過しますとヒビ割れが生じ、放熱効果を悪化させます。稠度の小さい(固い)放熱用シリコーングリースは、ビス止め時にモールド樹脂クラックの原因となります。

Volatile type silicone grease may produce cracks after elapse of long term, resulting in reducing heat radiation effect. Silicone grease with low consistency (hard grease) may cause cracks in the mold resin when screwing the product to a heatsink.

040114 SSJ-02600 12 / 14

弊社では、寿命に影響を与えない下記の放熱用シリコーングリースを推奨しております。

Out recommended silicone grease for heat radiation purpose, which will not cause any adverse effect on the product life is indicated below:

品名 Type	メーカー名	Suppliers
G746	信越化学工業(株)	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
YG6260	東芝シリコーン(株)	Toshiba Silicone Co., Ltd.
SC102	東レ・ダウコーニング・シリコーン(株)	Dow Corning Toray Silicone Co., Ltd.

10-5 半田付け方法

Soldering

半田付けの際は、下記条件以内でできるだけ短時間に作業をするよう、ご配慮ください。 When soldering the products, please be sure to minimize the working time, within the following conditions.

• 260 ± 5 10sec.

・380±5 3sec. (半田ごて)

Soldering iron

半田付けは製品本体より 1.5mm のところまでとする。

at a distance of 1.5mm from the main body of the Products

10-6 静電気破壊防止のための取扱注意

Considerations to protect the Products from Electrostatic Discharge

デバイスを取り扱う場合は、人体アースを取ってください。人体アースはリストストラップ等を用い、感電防止のため、1M の抵抗を人体に近い所へ入れてください。

When handling the devices, operator must be grounded. Grounded wrist straps be worn and should have at least 1M of resistance near operators to ground to prevent shock hazard.

デバイスを取り扱う作業台は導電性のテーブルマットやフロアマット等を敷きアースを取ってください。

Workbenches where the devices are handled should be grounded and be provided with conductive table and floor mats.

カーブトレーサーなどの測定器を使う場合、測定器もアースを取ってください。

When using measuring equipment such as a curve tracer, the equipment should also be grounded.

半田付けをする場合、半田ごてやディップ槽のリーク電圧がデバイスに印加されるのを防ぐため、半田ごての先やディップ槽をアースしてください。

When soldering the devices, the head of a soldering iron or a solder bath must be grounded in other to prevent leak voltage generated by them from being applied to the devices.

デバイスを入れる容器は、弊社出荷時の容器を用いるか、導電性容器やアルミ箔等で、静電対策をしてください。

The devices should always be stored and transported in our shipping containers or conductive containers, or be wrapped up in aluminum foil.

040114 SSJ-02600 13 / 14

10-7その他

Others

本書に記載されている動作例及び回路例は、使用上の参考として示したもので、これらに起 因する当社もしくは第三者の工業所有権、知的所有権、その他の権利の侵害問題について当社は 一切責任を負いません。

Application and operation examples described in this document are quoted for the sole purpose of reference for the use of the products herein and Sanken can assume no responsibility for any infringement of industrial property rights, intellectual property rights or any other rights of Sanken or any third party which may result from its use.

本書に記載されている製品をご使用の場合は、これらの製品と目的物との組み合わせについて使用者の責任に於いて、検討・判断を行って下さい。

When using the products herein, the applicability and suitability of such products for intended purpose object shall be reviewed at the user's responsibility.

当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品では、ある確率での欠陥、故障の 発生は避けられません。部品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害を発 生させないよう、使用者の責任に於いて、装置やシステム上で十分な安全設計及び確認を行って 下さい。

Although Sanken undertakes to enhance the quality and reliability of its products, the occurrence of failure and defect of semiconductor products at a certain rate is inevitable.

Users of Sanken products are requested to take, at their own risk preventative measures including safety design of the equipment or systems against any possible injury, death, fires or damages to the society due to device failure or malfunction.

本書に記載されている製品は、一般電子機器(家電製品、事務機器、通信端末機器、計測機器など)に使用されることを意図しております。

高い信頼性が要求される装置(輸送機器とその制御装置、交通信号制御装置、防災・防火装置、各種安全装置など)への使用をご検討及び、一般電子機器であっても長寿命を要求される場合に つきましては、必ず当社販売窓口へのご相談及び納入仕様書への記載をお願いします。

極めて高い信頼性が要求される装置(航空宇宙機器、原子力制御、生命維持のための医療機器など)には当社の文書による合意がない限り使用しないで下さい。

Sanken products listed in this document are designed and intended for the use as components in general purpose electronic equipment or apparatus (home appliances, office equipment, telecommunication equipment, measuring equipment, etc.).

Whenever Sanken products are intended to be used in the applications where high reliability is required (transportation equipment and its control systems, traffic signal control systems or equipment, fire/crime alarm systems, various safety devices, etc.), and whenever long life expectancy is required even in general purpose electronic equipment or apparatus, please contact your nearest Sanken sales representative to discuss and obtain written consent of your specifications.

The use of Sanken products without the written consent of Sanken in the applications where extremely high reliability is required (aerospace equipment, nuclear power control systems, life support systems, etc.) is strictly prohibited.

本書に記載された製品は耐放射線設計をしておりません。

Anti radioactive ray design is not considered for the products listed herein

040114 SSJ-02600 14 / 14